
	<h2 style="color: #E67E22;">IPD048N06L3GBTMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD048N06L3GBTMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD048N06L3GBTMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD048N06L3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 58µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8400pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD048N06L3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD048N06L3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD048N06L3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD048N06L3GBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD046N08N5ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3</p>	 <p><b>IPD04N03LB</b> INF IPD04N03LB INF</p>	 <p><b>IPD04N03L</b> I IPD04N03L I</p>	 <p><b>IPD048N06L3 G</b> infineon IPD048N06L3 G infineon</p>
 <p><b>IPD048N06L3G</b> INFINEO IPD048N06L3G INFINEO</p>	 <p><b>IPD04N03LA G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A DPAK</p>	 <p><b>IPD04N03LAG</b> INFINEO IPD04N03LAG INFINEO</p>	 <p><b>IPD042P03L3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD048N06L3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD048N06L3GBTMA1 Datenblatt	IPD048N06L3GBTMA1-Datenblätter	IPD048N06L3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD048N06L3GBTMA1
IPD048N06L3GBTMA1 Electronic	IPD048N06L3GBTMA1-Komponenten	IPD048N06L3GBTMA1-Verteiler	IPD048N06L3GBTMA1-Bild	IPD048N06L3GBTMA1-Teil
IPD048N06L3GBTMA1 Preis	IPD048N06L3GBTMA1 Hersteller	IPD048N06L3GBTMA1 Bild	IPD048N06L3GBTMA1 Aktie	IPD048N06L3GBTMA1 Inventar
IPD048N06L3GBTMA1 Neu	IPD048N06L3GBTMA1 Original	IPD048N06L3GBTMA1 garantiert	IPD048N06L3GBTMA1 RFQ	IPD048N06L3GBTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited